

HPE メモリ主導型フラッシュ

高速メモリでデータを有効活用する
新しいクラスのエンタープライズストレージ



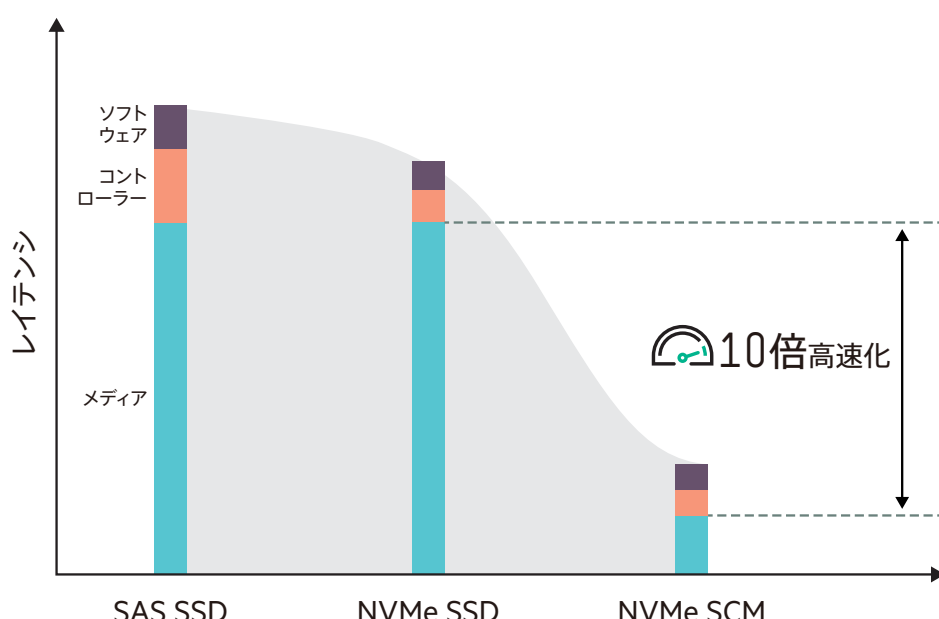
「多くの企業が認識している唯一にして最大の課題はパフォーマンスの予見性であり、企業は予想通り低レイテンシであることを求めるだけでなく、環境が大きくなる中で定義済みのサービス内容合意書 (SLA) に対応し続けられるようにしなければなりません」

- IDC¹

さらに先へと進んで処理を高速化し、
オールフラッシュを超えることで現状を打破



- ↓ レイテンシの短縮と一貫性の向上
- + 耐久性の向上
- = 効率の向上



パフォーマンスの障壁を打ち破るための4つの要件

- 1 インテリジェントソフトウェアによる高速化
- 2 メモリ主導
DRAMとNANDフラッシュのギャップをSCMで解消
- 3 並列処理
SCMのメリットをNVMeで最大限に活用
- 4 フラッシュストレージ
容量階層としてSSDを展開

HPE メモリ主導型フラッシュとは

以下の実現を強力にサポートする新しいクラスのエンタープライズストレージ

導入時
高速

最大50%
レイテンシを短縮

状態の維持
高速

レイテンシは
平均200マイクロ秒未満

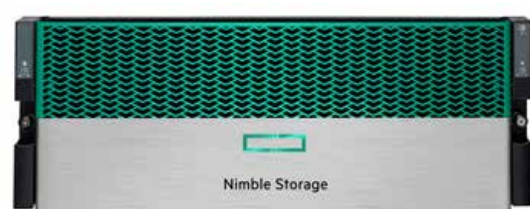
常時
高速

ほぼすべてのI/Oで
300マイクロ秒未満の
レイテンシ

誰もが簡単に利用できるよう高速メモリを実用化



中断なし
フォークリフトアップグレードが不要



HPE Nimble Storage

常時稼働のデータ削減機能で
効率を最大限まで高め、すべてがSCMの場合と
同等のパフォーマンスを実現



HPE 3PAR ストレージ

予測可能な最小のレイテンシを
大規模な環境で実現することで、
ミッションクリティカルなワークロードに対応

詳細情報

<https://www.hpe.com/jp/ja/storage/hpe-memory-driven-flash.html>

¹ IDC ホワイトペーパー (HPE 後援)、「ストレージクラスメモリでオールフラッシュを超える進化を遂げ、次世代のイノベーションを実現するエンタープライズストレージ」、2018年11月26日。